(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-50481 (P2002-50481A)

(43)公開日 平成14年2月15日(2002.2.15)

(51) Int.Cl.7		酸別記号	F I	テーマコード(参考)
H05B	33/14		H 0 5 B 33/14	B 3K007
C09K	11/06	6 1 0	C 0 9 K 11/06	6 1 0
H05B	33/22		H 0 5 B 33/22	В

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願2000-236645(P2000-236645)	(71)出願人	000003159
			東レ株式会社
(22)出顧日	平成12年8月4日(2000.8.4)		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者	小濱 亨
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	西山 卓哉
			滋賀県大津市閩山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	北澤 大輔
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		Fターム(参	考) 3K007 AB03 AB04 AB11 BA06 CA01
			CB01 DA01 DB03 DC00 EB00

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】

【課題】発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた、発 光素子を提供する。

【解決手段】正極と負極の間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、該素子が3つ以上の環構造を含む炭化水素芳香族縮合環で置換されている三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体を含むことを特徴とする発光素子。



【特許請求の範囲】

【請求項1】正極と負極の間に発光物質が存在し、電気 エネルギーにより発光する素子であって、該素子が3つ 以上の環構造を含む炭化水素芳香族縮合環で置換されて いる三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体を含むこと を特徴とする発光素子。

【請求項2】三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体が 下記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項1 記載の発光素子。

【化1】

$$\begin{array}{c}
Ar^{1} \\
R^{3} \\
Ar^{2} \\
Ar^{3}
\end{array}$$
(1)

(ここでR¹~R³はそれぞれ、水素、アルキル基、シク ロアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シクロア ルケニル基、アルキニル基、水酸基、メルカプト基、ア ルコキシ基、アルキルチオ基、アリールエーテル基、ア リールチオエーテル基、アリール基、複素環基、ハロゲ ン、ハロアルカン、ハロアルケン、ハロアルキン、シア ノ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシル基、 エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シ リル基、シロキサニル基の中から選ばれる。Ar¹~A r³はそれぞれ、無置換または置換のターフェニル基、 無置換または置換のフルオレン基、無置換または置換の フェナンスレン基、無置換または置換のアントラセン 基、無置換または置換のピレン基、無置換または置換の ペリレン基の中から選ばれる。)

【請求項3】該有機蛍光体が発光材料であることを特徴 とする請求項1記載の発光素子。

【請求項4】 該有機蛍光体が電子輸送材料であることを 特徴とする請求項1記載の発光素子。

【請求項5】マトリクスおよび/またはセグメント方式 によって表示するディスプレイであることを特徴とする 請求項1記載の発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 40 光に変換できる素子であって、表示素子、フラットパネ ルディスプレイ、バックライト、照明、インテリア、標 識、看板、電子写真機、光信号発生器などの分野に利用 可能な発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 された正孔が両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合する 際に発光するという有機積層薄膜発光素子の研究が近年 活発に行われている。この素子は、薄型、低駆動電圧下 特徴であり注目を集めている。

【0003】この研究は、コダック社のC. W. Tan gらが有機積層薄膜素子が高輝度に発光することを示し て以来 (Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21, p. 913, 1987)、多くの研究機関が検討 を行っている。コダック社の研究グループが提示した有 機積層薄膜発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基 板上に正孔輸送性のジアミン化合物、発光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてM 10 g:Agを順次設けたものであり、10 V程度の駆動電 圧で1000cd/m²の緑色発光が可能であった。現 在の有機積層薄膜発光素子は、上記の素子構成要素の他 に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているも のもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏襲してい

【0004】発光層はホスト材料のみで構成されたり、 ホスト材料にゲスト材料をドーピングして構成される。 発光材料は三原色揃うことが求められているが、これま では緑色発光材料の研究が最も進んでいる。現在は赤色 発光材料と青色発光材料において、特性向上を目指して 鋭意研究がなされている。特に青色発光材料において高 輝度で色純度の良い発光の得られるものが望まれてい

【0005】ホスト材料としては、前述のトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを始めとするキノリノール 誘導体の金属錯体、ベンズオキサゾール誘導体、スチル ベン誘導体、ベンズチアゾール誘導体、チアジアゾール 誘導体、チオフェン誘導体、テトラフェニルブタジエン 誘導体、シクロペンタジエン誘導体、オキサジアゾール 誘導体、オキサジアゾール誘導体金属錯体、ベンズアゾ ール誘導体金属錯体などがあげられる。

【0006】 青色発光ホスト材料においては、比較的良 い性能が得られている例として、キノリノール誘導体と 異なる配位子を組み合わせた金属錯体(特開平5-21 4332号公報)や、ビススチリルベンゼン誘導体(特 開平4-117485号公報)などがあげられるが、特 に色純度が充分ではない。

【0007】一方、ゲスト材料としてのドーパント材料 には、レーザー色素として有用であることが知られてい る、7-ジメチルアミノー4-メチルクマリンを始めと するクマリン誘導体、ペリレン、ピレン、アントラセン などの縮合芳香環誘導体、スチルベン誘導体、オリゴフ エニレン誘導体、フラン誘導体、キノロン誘導体、オキ サゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体などが知られ ている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術に用 いられる発光材料(ホスト材料、ドーパント材料)に は、発光効率が低く消費電力が高いものや、耐久性が低 での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多色発光が 50 く素子寿命の短いものが多かった。また、フルカラーデ

30



ィスプレイとして赤色、緑色、青色の三原色発光が求め られているが、赤色、青色発光においては、発光波長を 満足させるものは少なく、発光ピークの幅も広く色純度 が良いものは少ない。中でも青色発光において、耐久性 に優れ十分な輝度と色純度特性を示すものが必要とされ

【0009】本発明は、かかる従来技術の問題を解決 し、発光効率が高く、高輝度で色純度に優れた発光素子 を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、正極と負極の 間に発光物質が存在し、電気エネルギーにより発光する 素子であって、該素子が3つ以上の環構造を含む炭化水 素芳香族縮合環で置換されている三置換ベンゼン骨格を 有する有機蛍光体を含むことを特徴とする発光素子であ る。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明において正極は、光を取り 出すために透明であれば酸化錫、酸化インジウム、酸化 錫インジウム (ITO) などの導電性金属酸化物、ある いは金、銀、クロムなどの金属、ヨウ化銅、硫化銅など の無機導電性物質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポ リアニリンなどの導電性ポリマなど特に限定されるもの でないが、ITOガラスやネサガラスを用いることが特 に望ましい。透明電極の抵抗は素子の発光に十分な電流 が供給できればよいので限定されないが、素子の消費電 力の観点からは低抵抗であることが望ましい。例えば3 00Ω/□以下のITO基板であれば素子電極として機 能するが、現在では10Ω/□程度の基板の供給も可能 になっていることから、低抵抗品を使用することが特に 望ましい。ITOの厚みは抵抗値に合わせて任意に選ぶ 事ができるが、通常100~300nmの間で用いられ ることが多い。また、ガラス基板はソーダライムガラ ス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも機械 的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、0.5 mm以上あれば十分である。ガラスの材質については、 ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無アルカ リガラスの方が好ましいが、SiO2 などのバリアコー トを施したソーダライムガラスも市販されているのでこ れを使用できる。ITO膜形成方法は、電子線ビーム 法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受け るものではない。

【0012】本発明において陰極は、電子を本有機物層 に効率良く注入できる物質であれ特に限定されないが、 一般に白金、金、銀、銅、鉄、錫、亜鉛、アルミニウ ム、インジウム、クロム、リチウム、ナトリウム、カリ ウム、カルシウム、マグネシウムなどがあげられるが、 電子注入効率をあげて素子特性を向上させるためにはリ チウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシ

る。しかし、これらの低仕事関数金属は、一般に大気中 で不安定であることが多く、例えば、有機層に微量のリ チウムやマグネシウム (真空蒸着の膜厚計表示で1 n m 以下)をドーピングして安定性の高い電極を使用する方 法が好ましい例として挙げることができるが、フッ化リ チウムのような無機塩の使用も可能であることから特に これらに限定されるものではない。更に電極保護のため に白金、金、銀、銅、鉄、錫、アルミニウム、インジウ ムなどの金属、またはこれら金属を用いた合金、そして シリカ、チタニア、窒化ケイ素などの無機物、ポリビニ ルアルコール、塩化ビニル、炭化水素系高分子などを積 層することが好ましい例として挙げられる。これらの電 極の作製法も抵抗加熱、電子線ビーム、スパッタリン グ、イオンプレーティング、コーティングなど導通を取 ることができれば特に制限されない。

【0013】本発明において発光物質とは、1)正孔輸 送層/発光層、2)正孔輸送層/発光層/電子輸送層、 3) 発光層/電子輸送層、4) 正孔輸送層/発光層/正 孔阻止層、5)正孔輸送層/発光層/正孔阻止層/電子 輸送層、6)発光層/正孔阻止層/電子輸送層そして、 20 7) 以上の組合わせ物質を一層に混合した形態のいずれ であってもよい。即ち、素子構成としては、上記1)~ 6) の多層積層構造の他に7) のように発光材料単独ま たは発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む層を 一層設けるだけでもよい。さらに、本発明における発光 物質は自ら発光するもの、その発光を助けるもののいず れにも該当し、発光に関与している化合物、層などを指 すものである。

【0014】本発明において正孔輸送層は正孔輸送性物

質単独または二種類以上の物質を積層、混合するか正孔 輸送性物質と高分子結着剤の混合物により形成される。 正孔輸送性物質としては電界を与えられた電極間におい て正極からの正孔を効率良く輸送することが必要で、正 孔注入効率が高く、注入された正孔を効率良く輸送する ことが望ましい。そのためにはイオン化ポテンシャルが 小さく、しかも正孔移動度が大きく、さらに安定性に優 れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に発生 しにくい物質であることが要求される。このような条件 を満たす物質として、特に限定されるものではないが、 40 -1, 4'ージフェニルー1,1'ージアミンなどのトリフェ ニルアミン類、ピス (N-アリルカルバゾール) または ビス (N-アルキルカルバゾール) 類、ピラゾリン誘導 体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、オキサ ジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体、ポルフィリ ン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系では前 記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレン誘 ウムまたはこれら低仕事関数金属を含む合金が有効であ 50 導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシランなどが好ま

30

6

しいが、素子作製に必要な薄膜を形成し、正極から正孔 が注入できて、さらに正孔を輸送できる化合物であれば 特に限定されるものではない。

【0015】本発明における発光材料はホスト材料のみでも、ホスト材料とドーパント材料の組み合わせでも、いずれであってもよい。また、ドーパント材料はホスト材料の全体に含まれていても、部分的に含まれていても、いずれであってもよい。ドーパント材料は積層されていても、分散されていても、いずれであってもよい。

【0016】本発明において発光材料は、3つ以上の環構造を含む炭化水素芳香族縮合環で置換されている三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体を含む。炭化水素芳香族縮合環部分が蛍光性を有し、ベンゼン骨格で連結される構造である。蛍光スペクトルと分子の共役長には相関があり、炭化水素芳香族縮合環の環構造が小さいと共役長も短く、紫外領域の蛍光スペクトルを有することになる。炭化水素芳香族縮合環の蛍光スペクトルが可視領域にあるためには、3つ以上の環構造を含むことが必要である。

【0017】3つ以上の環構造を含む炭化水素芳香族縮合環としては特に限定されるものではないが、ターフェニル、クオーターフェニル、キンキフェニル、セクシフェニル等のパラフェニレン誘導体、フルオレン、ビフェニレン、、ジヒドロアントラセン、ジベンゾスベラン、トラキセン、トリプチセン等の脂肪族芳香族縮合環誘導体、アントラセン、フェナンスレン、ピレン、ペリレン、フルオランテン、クリセン、コロネン等の芳香族縮合環誘導体等があげられる。中でも、ターフェニル、フルオレン、フェナンスレン、アントラセン、ピレン、ペリレンが好ましい。

【0018】三置換ベンゼンの置換位置は特に限定されるものではないが、合成の容易さ等から、1,3,5位が好ましい。

【0019】三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体は 具体的には下記一般式(1)で表される。

[0020]

【化2】

ボキシル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基、ニトロ基、シリル基、シロキサニル基の中から選ばれる。 $A r^1 \sim A r^3$ はそれぞれ、無置換または置換のターフェニル基、無置換または置換のフルオレン基、無置換または置換のアントラセン基、無置換または置換のピレン基、無置換または置換のペリレン基の中から選ばれる。

【0022】これらの置換基の内、アルキル基とは例え ばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの飽 和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換でも置換され ていてもかまわない。また、シクロアルキル基とは例え ばシクロプロピル、シクロヘキシル、ノルボルニル、ア ダマンチルなどの飽和脂環式炭化水素基を示し、これは 無置換でも置換されていてもかまわない。また、アラル キル基とは例えばベンジル基、フェニルエチル基などの 脂肪族炭化水素を介した芳香族炭化水素基を示し、脂肪 族炭化水素と芳香族炭化水素はいずれも無置換でも置換 されていてもかまわない。また、アルケニル基とは例え ばビニル基、アリル基、ブタジエニル基などの二重結合 を含む不飽和脂肪族炭化水素基を示し、これは無置換で も置換されていてもかまわない。また、シクロアルケニ ル基とは例えばシクロペンテニル基、シクロペンタジエ ニル基、シクロヘキセン基などの二重結合を含む不飽和 脂環式炭化水素基を示し、これは無置換でも置換されて いてもかまわない。また、アルキニル基とは例えばアセ チレニル基などの三重結合を含む不飽和脂肪族炭化水素 基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわな い。また、アルコキシ基とは例えばメトキシ基などのエ ーテル結合を介した脂肪族炭化水素基を示し、脂肪族炭 化水素基は無置換でも置換されていてもかまわない。ま た、アルキルチオ基とはアルコキシ基のエーテル結合の 酸素原子が硫黄原子に置換されたものである。また、ア リールエーテル基とは例えばフェノキシ基などのエーテ ル結合を介した芳香族炭化水素基を示し、芳香族炭化水 素基は無置換でも置換されていてもかまわない。また、 アリールチオエーテル基とはアリールエーテル基のエー テル結合の酸素原子が硫黄原子に置換されたものであ る。また、アリール基とは例えばフェニル基、ナフチル 基、ビフェニル基、フェナントリル基、ターフェニル 基、ピレニル基などの芳香族炭化水素基を示し、これは 無置換でも置換されていてもかまわない。また、複素環 基とは例えばフリル基、チエニル基、オキサゾリル基、 ピリジル基、キノリル基、カルバゾリル基などの炭素以 外の原子を有する環状構造基を示し、これは無置換でも 置換されていてもかまわない。ハロゲンとはフッ素、塩 素、臭素、ヨウ素を示す。ハロアルカン、ハロアルケ ン、ハロアルキンとは例えばトリフルオロメチル基など の、前述のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基の 一部あるいは全部が、前述のハロゲンで置換されたもの

わない。アルデヒド基、カルボニル基、エステル基、カルバモイル基、アミノ基には脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環などで置換されたものも含み、さらに脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素、複素環は無置換でも置換されていてもかまわない。シリル基とは例えばトリメチルシリル基などのケイ素化合物基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。シロキサニル基とは例えばトリメチルシロキサニル基などのエーテル結合を介したケイ素化合物基を示し、これは無置換でも置換されていてもかまわない。また、隣接置換基との間に環構造を形成しても構わない。形成される環構造は無置換でも置換されていてもかまわない。

【0023】上記の三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍 光体として、具体的には下記のような構造があげられ る。

[0024]

【化3】

【0025】 【化4】

特開2002-50481 10

【0026】三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体は ドーパント材料として用いてもかまわないが、優れた電 子輸送能を有することから、ホスト材料として好適に用 いられる。

【0027】本発明におけるホスト材料は三層換ベンゼ ン骨格を有する有機蛍光体一種のみに限る必要はなく、 複数の三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体を混合し て用いたり、既知のホスト材料の一種類以上を三置換べ ンゼン骨格を有する有機蛍光体と混合して用いてもよ ないが、以前から発光体として知られていたアントラセ ン、フェナンスレン、ピレン、ペリレン、クリセンなど の縮合環誘導体、トリス(8-キノリノラト)アルミニ ウムを始めとするキノリノール誘導体の金属錯体、ベン ズオキサゾール誘導体、スチルベン誘導体、ベンズチア ゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、チオフェン誘導 体、テトラフェニルプタジエン誘導体、シクロペンタジ エン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ビススチリルア ントラセン誘導体やジスチリルベンゼン誘導体などのビ を組み合わせた金属錯体、オキサジアゾール誘導体金属 錯体、ベンズアゾール誘導体金属錯体、クマリン誘導 体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、チアジア ゾロピリジン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレン ビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、そして、 ポリチオフェン誘導体などが使用できる。

【0028】発光材料に添加するドーパント材料は、特 に限定されるものではないが、具体的には従来から知ら れている、フェナンスレン、アントラセン、ピレン、テ い。既知のホスト材料としては特に限定されるものでは 40 トラセン、ペンタセン、ペリレン、ナフトピレン、ジベ ンゾピレン、ルブレンなどの縮合環誘導体、ベンズオキ サゾール誘導体、ベンズチアゾール誘導体、ベンズイミ ダゾール誘導体、ベンズトリアゾール誘導体、オキサゾ ール誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアゾール誘導 体、イミダゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、トリ アゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、スチルベン誘導 体、チオフェン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導 体、シクロペンタジエン誘導体、ピススチリルアントラ セン誘導体やジスチリルベンゼン誘導体などのビススチ ススチリル誘導体、キノリノール誘導体と異なる配位子 50 リル誘導体、ジアザインダセン誘導体、フラン誘導体、

ベンゾフラン誘導体、フェニルイソベンゾフラン、ジメ シチルイソベンゾフラン、ジ(2-メチルフェニル)イ ソベンゾフラン、ジ(2-トリフルオロメチルフェニ ル) イソベンゾフラン、フェニルイソベンゾフランなど のイソベンゾフラン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、7 ージアルキルアミノクマリン誘導体、7ーピペリジノク マリン誘導体、7ーヒドロキシクマリン誘導体、7ーメ トキシクマリン誘導体、7-アセトキシクマリン誘導 体、3-ベンズチアゾリルクマリン誘導体、3-ベンズ イミダゾリルクマリン誘導体、3-ベンズオキサゾリル クマリン誘導体などのクマリン誘導体、ジシアノメチレ ンピラン誘導体、ジシアノメチレンチオピラン誘導体、 ポリメチン誘導体、シアニン誘導体、オキソベンズアン スラセン誘導体、キサンテン誘導体、ローダミン誘導 体、フルオレセイン誘導体、ピリリウム誘導体、カルボ スチリル誘導体、アクリジン誘導体、ビス(スチリル) ベンゼン誘導体、オキサジン誘導体、フェニレンオキサ イド誘導体、キナクリドン誘導体、キナゾリン誘導体、 ピロロピリジン誘導体、フロピリジン誘導体、1,2, 5-チアジアゾロピレン誘導体、ペリノン誘導体、ピロ ロピロール誘導体、スクアリリウム誘導体、ビオラント ロン誘導体、フェナジン誘導体、アクリドン誘導体、ジ アザフラビン誘導体などがそのまま使用できるが、特に イソベンゾフラン誘導体が好適に用いられる。

【0029】本発明において電子輸送性材料は、電界を 与えられた電極間において負極からの電子を効率良く輸 送することが必要で、電子注入効率が高く、注入された 電子を効率良く輸送することが望ましい。そのためには 電子親和力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さら に安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時および 使用時に発生しにくい物質であることが要求される。こ のような条件を満たす物質として、本発明における、3 つ以上の環構造を含む炭化水素芳香族縮合環で置換され ている三置換ベンゼン骨格を有する有機蛍光体や、8-ヒドロキシキノリンアルミニウムに代表されるキノリノ ール誘導体金属錯体、トロポロン金属錯体、フラボノー ル金属錯体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタ レン、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アル ダジン誘導体、ビススチリル誘導体、ピラジン誘導体、 フェナントロリン誘導体などがあるが特に限定されるも のではない。これらの電子輸送材料は単独でも用いられ るが、異なる電子輸送材料と積層または混合して使用し ても構わない。

【0030】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N-ピニルカルバゾー ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、 エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレ タン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キ シレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不 飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、 シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用い ることも可能である。

【0031】本発明において発光物質の形成方法は、抵 抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング、分子積 10 層法、コーティング法など特に限定されるものではない が、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着が特性面で 好ましい。層の厚みは、発光物質の抵抗値にもよるので 限定することはできないが、1~1000nmの間から 選ばれる。

【0032】本発明において電気エネルギーとは主に直 流電流を指すが、パルス電流や交流電流を用いることも 可能である。電流値および電圧値は特に制限はないが、 素子の消費電力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネ ルギーで最大の輝度が得られるようにするべきである。 【0033】本発明においてマトリクスとは、表示のた めの画素が格子状に配置されたものをいい、画素の集合 で文字や画像を表示する。画素の形状、サイズは用途に よって決まる。例えばパソコン、モニター、テレビの画 像および文字表示には、通常一辺が300 μ m以下の四 角形の画素が用いられるし、表示パネルのような大型デ ィスプレイの場合は、一辺がmmオーダーの画素を用い ることになる。モノクロ表示の場合は、同じ色の画素を 配列すればよいが、カラー表示の場合には、赤、赤、 緑、青の画素を並べて表示させる。この場合、典型的に はデルタタイプとストライプタイプがある。そして、こ のマトリクスの駆動方法としては、線順次駆動方法やア クティブマトリックスのどちらでもよい。線順次駆動の 方が構造が簡単であるという利点があるが、動作特性を 考慮した場合、アクティブマトリックスの方が優れる場 合があるので、これも用途によって使い分けることが必 要である。

【0034】本発明においてセグメントタイプとは、予 め決められた情報を表示するようにパターンを形成し、 決められた領域を発光させることになる。例えば、デジ タル時計や温度計における時刻や温度表示、オーディオ 機器や電磁調理器などの動作状態表示、自動車のパネル 表示などがあげられる。そして、前記マトリクス表示と セグメント表示は同じパネルの中に共存していてもよ 6.1

【0035】本発明においてバックライトとは、主に自 発光しない表示装置の視認性を向上させる目的に使用さ れ、液晶表示装置、時計、オーディオ機器、自動車パネ ル、表示板、標識などに使用される。特に液晶表示装 置、中でも薄型化が課題となっているパソコン用途のバ ンオキサイド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン 50 ックライトとしては、従来方式のものが蛍光灯や導光板

からなっているため薄型化が困難であることを考えると 本発明におけるバックライトは、薄型、軽量が特徴にな る。

[0036]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0037】実施例1

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子(株)製、15Ω∕□、電子ビーム蒸着品)を 30×40mmに切断、エッチングを行った。得られた 基板をアセトン、"セミコクリン56" (フルウチ化学 (株) 製) で各々15分間超音波洗浄してから、超純水 で洗浄した。続いてイソプロピルアルコールで15分間 超音波洗浄してから熱メタノールに15分間浸漬させて 乾燥させた。この基板を素子を作製する直前に1時間U Vーオゾン処理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内 の真空度が5×10-5Pa以下になるまで排気した。抵 抗加熱法によって、まず正孔輸送材料として4.4'- \vec{U} ス (N-(m-h)) $-N-フェニルアミノ) <math>\vec{U}$ フ 20 ェニルを50 n m 蒸着した。次に発光材料として、1. 3, 5-トリス (p-ターフェニル) ベンゼンを15n mの厚さに積層した。次に電子輸送材料として、2,9 ージメチルー4, 7ージフェニルー1, 10ーフェナン トロリンを35nmの厚さに積層した。次にリチウムを 0. 5 n m 有機層にドーピングした後、アルミニウムを 200nm蒸着して陰極とし、5×5mm角の素子を作 製した。ここで言う膜厚は水晶発振式膜厚モニター表示 値である。発光特性として、輝度計、蛍光分光光度計、 色彩色差計を用いて、輝度、発光スペクトル、CIE色 30 度を測定した。この発光素子からは、発光波長405n m、CIE色度 (0.20、0.20) の良好な青色発 光が得られた。また上記発光素子を真空セル内で1mA パルス駆動(Duty比1/60、パルス時の電流値6 0 mA) させたところ、色純度の良好な高輝度青色発光 が確認された。

【0038】 実施例2

発光材料として1、3、5-トリス(2-フルオレニ ル) ベンゼンを用いた他は実施例1と全く同様にして発 光素子を作製した。この発光素子からは発光波長429 nm、CIE色度(0.21、0.25)の良好な青色 発光が得られた。

【0039】実施例3

発光材料として1,3,5-トリス(2-フェナンスレ ニル) ベンゼンを用いた他は実施例1と全く同様にして 発光素子を作製した。この発光素子からは発光波長51 7 nm、CIE色度(0.22、0.38)の良好な青 . 色発光が得られた。

【0040】実施例4

正孔輸送材料の蒸着までは実施例1と同様に行った。次 にホスト材料として実施例2で用いた1,3,5ートリ ス(2-フルオレニル)ベンゼンを、ドーパント材料と してジ(2-メチルフェニル)イソベンゾフラン(蛍光 ピーク波長は468nm) を用いて、ドーパントが1w t%になるように15nmの厚さに共蒸着した。次に電 子輸送材料の蒸着からは実施例1と同様して発光素子を 作製した。この発光素子からは、ドーパント材料の蛍光 スペクトルと同様の発光スペクトルが観察され、色純度 の良好な高輝度青色発光が得られた。

【0041】 実施例5

ITO透明導電膜を150nm堆積させたガラス基板 (旭硝子 (株) 製、15 Ω/□、電子ビーム蒸着品)を 30×40mmに切断、フォトリソグラフィ法によって 300μmピッチ (残り幅270μm) ×32本のスト ライプ状にパターン加工した。ITOストライプの長辺 方向片側は外部との電気的接続を容易にするために1. 27mmピッチ(開口部幅800μm)まで広げてあ る。得られた基板をアセトン、"セミコクリン"56で 各々15分間超音波洗浄してから、超純水で洗浄した。 続いてイソプロピルアルコールで15分間超音波洗浄し てから熱メタノールに15分間浸漬させて乾燥させた。 この基板を素子を作製する直前に1時間UV-オゾン処 理し、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が5 ×10-4Pa以下になるまで排気した。抵抗加熱法によ って、まず正孔輸送材料として4, 4'ービス(N-(m-トリル) -N-フェニルアミノ) ビフェニルを5 0 n m 蒸着し、実施例2で用いた1, 3, 5-トリス (2-フルオレニル) ベンゼンを15 nmの厚さに蒸着 した。次に電子輸送材料として、2,9-ジメチルー 4, 7-ジフェニルー1, 10-フェナントロリンを3 5 n m の厚さに積層した。ここで言う膜厚は水晶発振式 膜厚モニター表示値である。次に厚さ50μmのコバー ル板にウエットエッチングによって16本の250μm の開口部(残り幅50 μm、300 μmピッチに相当) を設けたマスクを、真空中でITOストライプに直交す るようにマスク交換し、マスクとITO基板が密着する ように裏面から磁石で固定した。そしてリチウムを0. 5 n m有機層にドーピングした後、アルミニウムを20 0 nm蒸着して32×16ドットマトリクス素子を作製 した。本素子をマトリクス駆動させたところ、クロスト ークなく文字表示できた。

[0042]

【発明の効果】本発明は、発光効率が高く、色純度に優 れた、発光素子を提供できるものである。特に青色発光 にとって有効なものである。

40